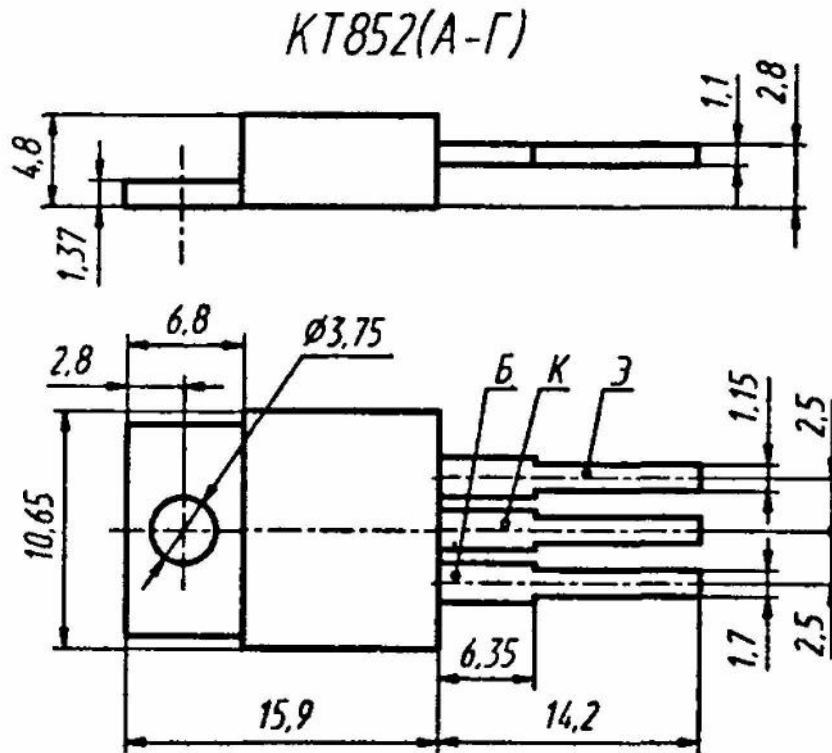


КТ852А, КТ852Б, КТ852В, КТ852Г

Транзисторы кремниевые планарные структуры $p-n-p$ переключательные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 4$ В, не менее:

$I_k = 2$ А	500
$I_k = 1$ А	1000

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кб} = 5$ В, $I_b = 0,5$ А, не менее

7 МГц

Граничное напряжение при $I_b = 0,03$ А, не менее:

КТ852А	100 В
КТ852Б	80 В
КТ852В	60 В
КТ852Г	45 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 2$ А, $I_b = 8$ мА, не более

2,5 В

Время включения при $U_{кз} = 30$ В, $I_k = 2$ А,

$I_B = 8$ мА, не более	2,6 мкс
Время выключения при $U_{КЭ} = 30$ В, $I_K = 2$ А, $I_B = 8$ мА, не более	4,5 мкс
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$, не более	1 мА
Обратный ток коллектор—эмиттер, не более:	
при $U_{КЭ} = 50$ В для КТ852А	2 мА
при $U_{КЭ} = 40$ В для КТ852Б	2 мА
при $U_{КЭ} = 30$ В для КТ852В	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{КЭ} = 5$ В, не более	2 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 100$ кГц, не более	28 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1,5$ В, $f = 100$ кГц, не более	63 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база, коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм:	
КТ852А	100 В
КТ852Б	80 В
КТ852В	60 В
КТ852Г	45 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	2 А
Импульсный ток коллектора при $t_M \leq 10$ мс, $Q \geq 100$	4 А
Постоянный ток базы	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора при $T_K = -60...+25$ °С:	
без теплоотвода ¹	2 Вт
с теплоотводом	50 Вт
Температура p - n перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_K =$ = +100 °С

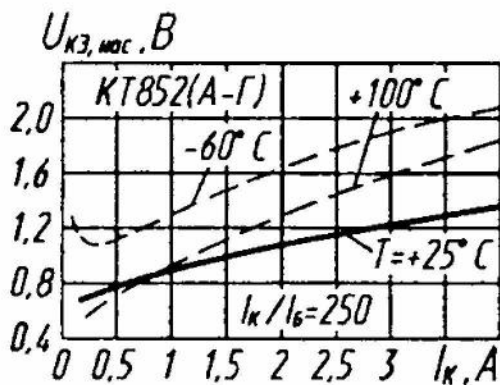
¹ При $T_K > +25$ °С $P_{K \text{ МАКС}}$ снижается линейно на 0,15 Вт/°С.

Допускается одноразовый изгиб выводов транзисторов не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° с радиусом закругления не менее 0,8 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб выводов в плоскости выводов не допускается.

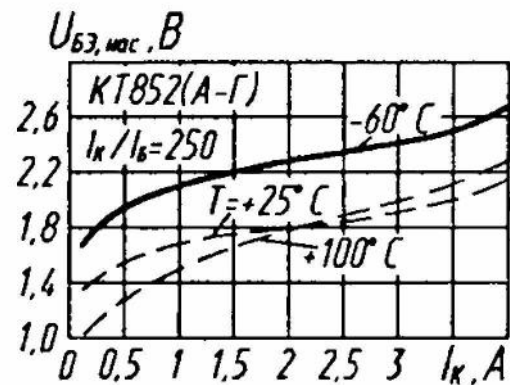
Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре не более +260 °С в течение не более 3 с. Допускается пайка волной припоя при температуре не более +240 °С.

Запрещается припайка основания транзисторов к теплоотводу.

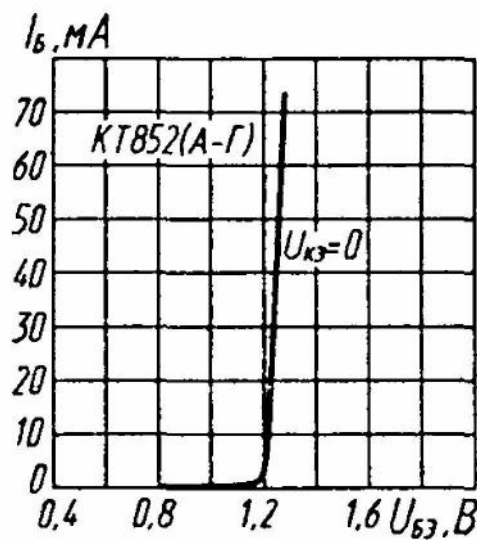
Допустимое значение статического потенциала 1000 В.



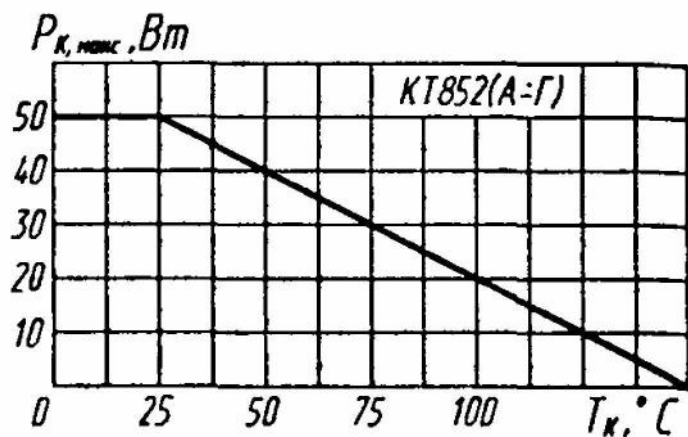
Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



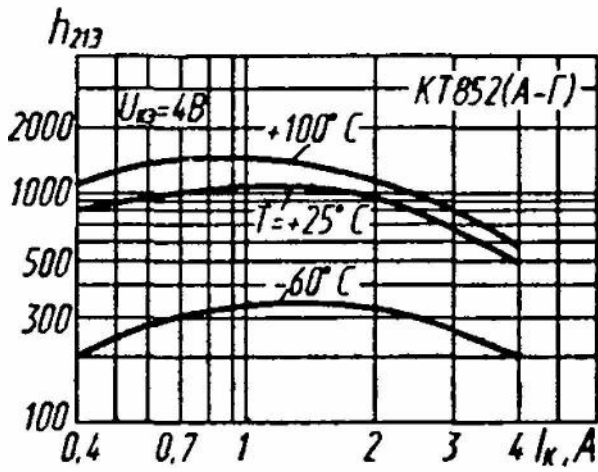
Зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



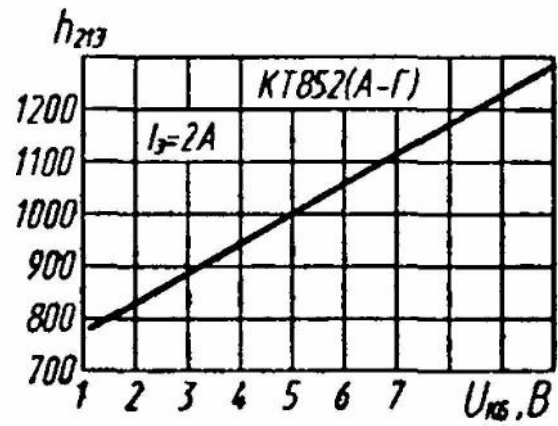
Входная характеристика



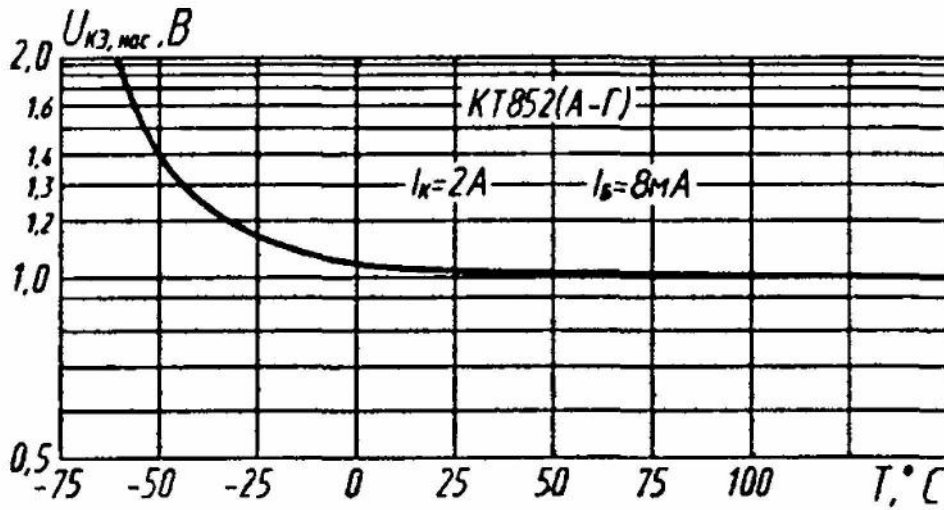
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



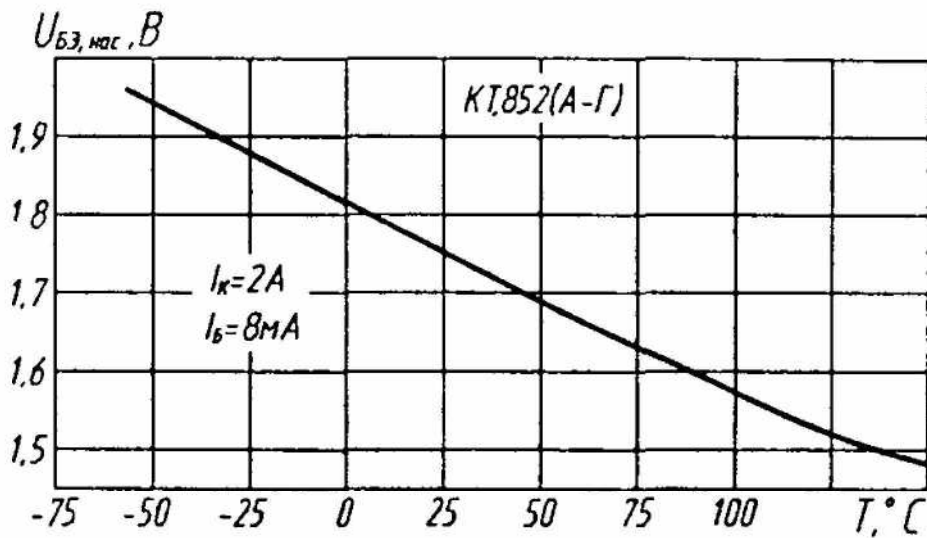
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор—база



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от температуры



Зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от температуры

Области максимальных режимов

